古久根 伸吉,李 相錫

鳥取大学大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻

1. 序論

1.1 Metal-Organic Frameworks (MOF)とは

金属有機構造体(MOF)とは金属イオンと有機配位 子からなるハイブリット材料で,規則的に並んだナ ノメートルオーダーの細孔を持つ多孔性材料である. 様々な金属イオンとそれらを連結する架橋性の有機 配位子を混合することで、三次元の骨格構造を持つ 結晶を作る. MOF の骨格構造は、金属イオンと有機 配位子のサイズや種類を変更することにより,従来 の多孔性材料(活性炭やゼオライトなど)にはできな い分子レベルの構造制御が可能である. この設計の 自由度の高さから, MOF は分子レベルの細孔サイズ や形状の制御が可能となっている.また合成法は容 易であり 2 つ以上の相互作用点(配位結合や水素結 合部位)を持つ有機配位子と金属イオンを有機配位 子のみまたは金属イオンと有機配位子のみの溶液を ゲスト分子存在下において混合することで MOF 結 晶を得られる. そして多くの場合室温・常圧化で(水 熱合成等の例外もある)混合を行う. すると即座に 構成要素同士が配位結合し、自己組織化することに より均一な骨格構造が得られる.



Fig. 1.MOF 結晶の概略図

1.2 MOF のデバイス応用に関して

MOF の比表面積は 10,400 m/g にも達しており, 固体材料における比表面積は他材料と比較しても非 常に有用性がある.加えて,特定の吸着分子に合わ せて細孔の大きさと機能性が制御できることも MOF の優れた点である.MOF はこのような高い比 表面積や機能性を利用した天然ガスの貯蔵や気相分 離,触媒,クロマトグラフィー,ドラッグデリバリ ーなどの幅広い応用において期待されている.そし て,安価な無機半導体の特性と有機ポリマーの製造 の容易さを持つ新材料としてナノエレクトロニクス の分野においても注目を集めている.ガスセンサに おいては高い比表面積を生かした作製が容易なセン サとして近年 MEMS 技術を用いた MOF のセンサの 研究[1]が行われており,本研究ではガスセンサの 作製のために,様々なガスを封入させた MOF のガ ス吸着ディップを測定することで,MOFのガスセン サとしての特性を解明し,ガスセンサ応用を実現す ることを目的として実験を行った.

2. デバイスの作製法

本研究ではCuイオンと1,3,5-ベンゼントリカルボン酸(btc)からなる HKUST-1 を使用した. HKUST-1 薄膜を以下のように合成した. 合成手順の概略を Fig. 3 に示す. まずエタノールに btc を溶解させた 合成溶液を作製する. 合成溶液とは別に, SiO. 基板 上にスパッタリング法を用いて Cu を堆積させ, Cu/SiO. 基板を作製する. 合成溶液を入れたバイア ルを電気炉で 50℃まで加熱し,合成溶液中に Cu/SiO.基板を浸漬する. このまま一定時間浸漬し続 けると, Cu 基板上に HKUST-1 薄膜が合成される. その後熱硬化樹脂(PDMS)をスピンコーターを用い て基板上に塗布し, リフトオフを行った.



Table 1 HKUST-1 薄膜の合成条件

| Cu 膜厚 | 配位子濃度 | 浸漬時間 |
|-------|---------|------|
| [nm] | [mol/L] | [h] |
| 500 | 0.0048 | 12 |

Table 2 PDMS の塗布条件

| スピンコーターの | スピンコーターの |
|-----------|----------|
| 回転速度[rpm] | 回転時間[s] |
| 400 | 30 |

3. 実験結果・考察

3.1 結晶性評価

3.1.1 SEM による結晶性評価

Fig.4 に作製したデバイスのSEM像を示す.Fig.4 より,デバイスの表面に HKUST-1 多結晶薄膜が得 られた.

3.1.2 X線回折(XRD)による結晶性評価

Fig. 5 に作製したデバイスの XRD による回折結 果を示す. XRD の測定結果より PDMS 剥離前後に HKUST-1 のピークが確認できるため, デバイス上に HKUST-1 薄膜が存在することがわかった.



Fig. 4. 作製したデバイスの SEM 像



Fig. 5. 作製したデバイスのX線回折結果

3.2 ガスセンサとしての評価

3.2.1 ガスの吸着方法

MOF のガス吸着方法としてはグローブボックス 内に CO_2 , Ar, N_2 , C. ガスをそれぞれ置換し,上記のデ バイス作製法で示した MOF/PDMS 基板をグローブ ボックス内に暴露する.その後 MOF/PDMS 薄膜上 に PDMS を用いてガスを封入することで MOF 薄膜 にガスを吸着させた.

3.2.2 THz 波による透過特性

THz 波による吸収ピークを Fig. 6 に示す. いずれのTHz 透過特性も十分なディップを得られずデバイスのガス吸着特性が確認できないことが分かる.



Fig. 6. CO₂, Ar, N₂, C, ガスの THz 透過特性 (sampleA はガス吸着を行っていないデバイス)

3.2.3 FTIR による透過特性

Fig. 7 に CO.のデータベースの FTIR の透過特性を 示す. Fig. 8 に今回の実験で CO.を吸着させたデバイ スの透過特性を示す.吸収ディップを比較すると, ガス吸着を行ったデバイスには CO.と同じ透過特性 が得られなかった.他のガスもデータベースと比較 したが,同じ吸収ディップを得られなかった.原因 としては,ガスの封止に使用した PDMS からガスが 漏れてしまったと考えられる.また,ガス吸着を行 う HKUST-1 薄膜の膜厚が吸収ディップを確認でき るほど厚くないといったことが考えられる.



Fig. 7. データベースにおける CO:透過特性[2]



Fig. 8. CO ガス吸着デバイスの透過特性

4. 結論

MOF のガス吸着特性の解明とガスセンサ作製の ために FTIR, THz による透過測定を行った.しかし, PDMS でのガス封止方法や MOF の膜厚がガス吸着 ディップが得られなかった原因であると考えられる. 今後は別の樹脂によるガス封止を行うことで, MOF のガスセンサの作製を実現していく必要があ る.

REFERENCES

 K. Lauren, L. Kirsty, "Metal–Organic Framework Materials as Chemical Sensors," Chemical Reviews, vol. 112, No. 2, pp. 1105-1125, 2012.
NIST Chemistry WebBook, SRD 69, 2018.